| CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL (37 CFR 1.8)  Applicant(s): Tomoko AOKI et al.  Serial No. 10/565,429  Filing Date January 28, 2000  Filing Date January 28, 2000  BY USING THE SAME  I hereby certify that this JP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence)  is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on May 8, 2006  (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)  Note: Each paper must have its own certificate of mailing. | ••                   |                            |   |   |
|---|----------------------|----------------------------|---|---|
| Applicant(s): Tomoko AOKI et al.  Serial No. 10/565,429  January 28, 2000  Invention: COATING COMPOSITION AND LOW BELLEGISCO SILICEOUS MATERIAL PRODUCED  BY USING THE SAME  I hereby certify that this JP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence)  is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on May 8, 2006  (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  MARIA T. SANCHEZ  (Signature of Person Mailing Correspondence)   | CERTIFICATE OF       | MAILING BY FIRST           | CLASS MAIL (37 CFR 1.8)   | Docket No.  |
| I hereby certify that this IP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence) is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The  Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on  May 8, 2006 (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)  |                      |                            | OF 1  | 2003ЈР317   |
| I hereby certify that this JP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence) is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The  Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on  May 8, 2006 (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)  | Serial No.           | Filing Date                | Examiner  | Group Art Unit  |
| I hereby certify that this IP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence) is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The  Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on  May 8, 2006 (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)  |                      | _                          | MAN 10 to Be Assigned   | To Be Assigned  |
| I hereby certify that this JP 8-51271 - 5 Pages (Identify type of correspondence) is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on May 8, 2006 (Date)  MARIA T. SANCHEZ (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)  | Invention: COATING   | COMPOSITION AND LO         | \2.   9=7   | TERIAL PRODUCED                                       |
| I hereby certify that this JP 8-51271 - 5 Pages  (Identify type of correspondence)  is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on  May 8, 2006  (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)   |                      |                            | W BUT MARKE SILICEOUS WAT   | ERIAL I RODUCED                                       |
| is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The  Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231-0001 on   May 8, 2006  (Date)  MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)   | DI COM I             | THE SAME                   |   |   |
|   | is being deposited w | ith the United States Post | (Identify type of correspondence) tal Service as first class mail in an shington, D.C. 20231-0001 on  MARIA T. S  (Typed or Printed Name of Person Mailing) (Signature of Person Mailing) | May 8, 2006 (Date)  ANCHEZ  n Mailing Correspondence) |
|   |                      |                            |   |   |
|   |                      |                            |   |   |
|   |                      |                            |   |   |
|   |                      |                            |   |   |
|   |                      |                            |   |   |

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

## 特開平8-51271

(43)公開日 平成8年(1996)2月20日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 識別記号         | 庁内整理番号      | FΙ      | 技術表示箇所                |  |
|---------------------------|--------------|-------------|---------|-----------------------|--|
| H 0 5 K 3/28              | Α            |             |         |                       |  |
| C 0 4 B 35/589            |              |             |         |                       |  |
| H01L 23/28                | Z            | 6921-4E     |         |                       |  |
| H05K 1/03                 | 610 D        | 7511-4E     |         |                       |  |
|                           |              |             | C 0 4 B | 35/ 58 1 0 2 N        |  |
|                           |              |             | 審査請求    | 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁) |  |
| (21)出願番号                  | 特願平7-76211   | <del></del> | (71)出願人 | 590001418             |  |
|                           |              |             |         | ダウ・コーニング・コーポレーション     |  |
| (22)出願日                   | 平成7年(1995)3月 | 31日         |         | DOW CORNING CORPORA   |  |
|                           |              |             |         | TION                  |  |
| (31)優先権主張番号               | 2 2 1 5 9 7  |             |         | アメリカ合衆国ミシガン州ミッドランド    |  |
| (32)優先日                   | 1994年4月1日    |             |         | (番地なし)                |  |
| (33)優先権主張国                | 米国(US)       |             | (72)発明者 | ローレン アンドリュー ハルスカ      |  |
|                           |              |             | •       | アメリカ合衆国,ミシガン,ミッドラン    |  |
|                           |              |             |         | ド,ジェイムス ストリート 4510    |  |
|                           |              |             | (72)発明者 | キース ウィントン マイケル        |  |
|                           |              |             |         | アメリカ合衆国,ミシガン,ミッドラン    |  |
|                           |              |             |         | ド,シーパート 2715          |  |
|                           |              |             | (74)代理人 | 弁理士 石田 敬 (外3名)        |  |
|                           |              |             |         |                       |  |

(54) 【発明の名称】 エレクトロニクス基材上に保護被覆を形成する方法

## (57)【要約】

【目的】 様々なエレクトロニクス基材に対して有効な 保護被覆を形成する方法を提供する。

【構成】 ポリシラザンと充填剤とを含む被覆組成物を 基材に塗布し、次いでこの塗布された基材をポリシラザ ンをセラミックに変えるのに十分な温度で加熱すること を含む。

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリシラザンと充填剤を含んでなる被覆 組成物をエレクトロニクス基材上へ塗布し、この塗布さ れた基材を50~1000℃の範囲の温度で最高で6時 間加熱して当該被覆組成物をセラミックに変えることを 含む、エレクトロニクス基材上に保護被覆を形成する方 法。

【請求項2】 溶媒、前記ポリシラザン及び前記充填剤 を含む液体混合物を前記基材に塗布し、そして次に当該 溶媒を蒸発させることを含む方法により、前記被覆組成 10 物を前記基材に適用する、請求項1記載の方法。

【請求項3】 前記塗布された基材を、空気、02、酸素 プラズマ、不活性ガス、窒素、アンモニア、アミン類、 湿分及び№ 0 から選ばれた1又は2種以上の化合物を含 有している環境中で加熱する、請求項2記載の方法。

前記セラミック被覆の誘電率が8未満で 【請求項4】 ある、請求項1記載の方法。

前記セラミック被覆の誘電率が12より 【請求項5】 高い、請求項1記載の方法。

【請求項6】 請求項1記載の方法により被覆されたエ 20 レクトロニクス基材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポリシラザンと充填剤 を含んでなる組成物を使って保護被覆を形成する方法に 関する。これらの被覆は様々なエレクトロニクス基材に 対して有効である。

[0002]

【従来の技術】ポリシラザンを使用して電子デバイス上 にセラミック被覆を形成することは、当該技術分野にお 30 いて知られていることである。例えば、国際公開第93 **/02472号パンフレットには、ポリシラザン樹脂の** 溶液をエレクトロニクス基材に塗布し、続いてこの塗布 した基材を空気中で150~800℃の範囲内の温度で 加熱する方法が開示されている。しかし、この刊行物に は、被覆中で充填剤を使用することは記載されていな 41

【0003】同様に、ポリシラザンから得られたセラミ ック被覆中で充填剤を使用することも当該技術分野にお いて知られている (特開平3-52287号公報及び特 40 開平1-221466号公報)。しかしながら、これら の刊行物にそのような材料をエレクトロニクス基材に対 する保護被覆として使用することは記載されていない。

【0004】特開平3-250082号公報にも、ポリ シラザンから得られたセラミック中に導電性の粉体を混 入することが記載されている。しかし、それにはエレク トロニクス基材に対する保護被覆は記載されていない。

[0005]

【発明の開示】本発明の発明者らは、電子デバイスを保

んでなる組成物から形成することができることを見いだ した。

【0006】本発明は、エレクトロニクス基材の表面に 保護被覆を形成する方法と、それにより被覆された基材 とに関する。この方法は、ポリシラザンと充填剤とを含 んでなる組成物を最初にエレクトロニクス基材の表面に 塗布することを含むものである。次に、この塗布した基 材を、当該組成物をセラミック被覆に変えるのに十分な 温度で加熱する。

【0007】望ましい保護被覆を、ポリシラザンと充填 剤を含む組成物からエレクトロニクス基材上に形成する ことができる。それから得られた被覆の厚さ(例えば> 40 μm) は、ポリシラザンだけから得られたもの(例 えば<2μm) より厚い。発明者らは、充填剤に応じた 電気的性質を備えた、割れと細孔のないいろいろな被覆 を得ることができるということを見いだした。

【0008】これらの利点のために、本発明の被覆はエ レクトロニクス基材に対する保護被覆として特に有益で ある。このような被覆は、パッシベーション被覆もしく は誘電性被覆として、層間誘電性層として、トランジス タのようなデバイスを製造するためのドープされた誘電 性層として、キャパシタやキャパシタ様デパイス、多層 デバイス、3-Dデバイス、SOIデバイスを製造する ためのシリコン(ケイ素)を含有している顔料入りパイ ンダー系として、超伝導体、超格子デバイスのための被 覆として、いたずら防止 (tamperproof)被覆その他とし て、役立つことができよう。

【0009】ここで使用する「セラミック被覆」という 表現は、ポリシラザン-充填剤組成物を加熱後に得られ た硬質の被覆を指すものである。この被覆は、無定形シ リカ(SiO2)物質も、ポリシラザンと充填剤を加熱 することで得られる残留炭素、窒素、シラノール及び/ 又は水素(それぞれ例えば、Si-C、Si-N、Si -OH、Si-H)が完全になくなっていない無定形の シリカ様物質も含む。「充填剤」という表現は、ポリシ ラザン及び最終のセラミック被覆中に分配されている微 細に分割された固相を言うものである。「エレクトロニ クス基材」という表現は、シリコンに基づくデバイス、 ガリウムひ素に基づくデバイス、フォーカルプレーンア レー、オプトエレクトロニックデバイス、光電池及び光 学デバイスといったような、電子デバイス類や電子回路 類を包含するものである。

【0010】本発明の方法では、ポリシラザンと充填剤 を含む被覆組成物を基材へ適用し、次いでこの被覆した 基材を、ポリシラザンをセラミックに変えるのに十分な 温度で加熱することを含む方法によって、基材上に保護 セラミック被覆を形成する。

【0011】本発明において有用なポリシラザン(ある いはシラザンポリマー)は、当該技術分野においてよく **護するための有効な被覆をポリシラザンと充填剤とを含 50 知られており、それらの構造は特に重要ではない。これ**  らのポリシラザンは一般に、[R₂ SiNH]、[RSi (NH) 1.6]及び/又は[R₃ Si (NH) 1/2] タイプの単位を含有していて、これらの式中の各Rは、水素原子、炭素原子数 1~20のアルキル基、アリール基、及びアルケニル基から独立に選ばれる。当然、本発明で有用なポリシラザンは他のシラザン単位を含有してもよい。実例には、[MeSi (NH) 1.6]、[Me2 SiNH]、[ViSi (NH) 1.6]、[Vi₂ SiNH]、[PhMeSiNH]、[PhViSiNH]、[MeViSiNH]、[HSi (NH) 1.6]及び[H₂ SiNH]が含まれる。ここで使用するMeはメチル基であり、Viはビニル基であり、Phはフェニル基である。本 10発明を実施するには、ポリシラザンの混合物を使用してもよい。

【0012】本発明のポリシラザンは、当該技術分野で よく知られている手法によって調製することができる。 使用する実際の方法は重要ではない。適当なプレセラミ ックシラザンポリマー又はポリシラザンを、米国特許第 4540803号明細魯及び米国特許第4543344 号明細書の方法により調製してもよい。本発明のために 適当な他のポリシラザンを、米国特許第4312970 号、同第4340619号、同第4395460号及び 20 同第4404153号各明細書の方法により調製するこ とができる。適当なポリシラザンには、米国特許第44 82689号及び同第4397828号各明細書により 調製されるものも含まれる。なおこのほかのポリシラザ ンには、ヨーロッパ特許第351747号、米国特許第 4543344号、ヨーロッパ特許第332374号、 米国特許第4656300号又は第4689252号、 及び米国特許第5030744号各明細書のものが含ま れる。

【0013】殊に好ましいポリシラザンは、ポリマーの 30 繰返し単位に炭素がないものである。と言うのは、結果として得られた被覆に炭素の汚染がほとんどないからである。そのようなポリマーではMe<sub>3</sub> Si (NH)<sub>1/2</sub> のような末端プロック原子団を容認することができる。と言うのは、それらは後の熱分解工程中に除去されるからである

【0014】最も好ましいポリマーは、米国特許第43 40619号明細書及び米国特許第4540803号明 細書のものである。前者のシラザンポリマーは、一般式 (CI、R、Si)2NHの塩素含有ジシラザン又は塩素含有ジシラザンと、 かりが混合物を、一般式 (R'sSi)2NHのジシラザンと、 がりかん、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ジルコニウムランタン鉛、チタン酸ジルコニウムランタン鉛、チタン酸ジルコニウムカスが含まれる。これらの式におけるRはビニル基、 はではでは、一般式 (CI、R、Si)2NHのジシラザンと、 かりが表別では、 の如きものや、 放射線不透過性の材料 (放射線の透させて調製される。これらの式におけるRはビニル基、 とはでは、 の如きものや、 放射線不透過性の材料 (放射線の透させて調製される。これらの式におけるRはビニル基、 はでは、 アンチェン、 スズ、 パラジウム、 ストロンチウム、 タングステン及びビスマスの不溶性塩類のような もの (これらには炭酸塩、硫酸塩及び酸化物といったよりは 0~2.5 の値であり、 x+y0合計は x+y0 合計は x+y0 合計は x+y0 合計は x+y0 に不透明な充填剤、 例えば無機顔料、 空化ケイ素粉末、 シリカ及びア

メチルポリジシリラザンを生成することを伴うものである。生成物のシラザンポリマーは比較的高い塩素イオン 含有量を有することがあり、そしてそれは本発明で使用する前に低下させることが好ましい。そのような除去のための方法は、米国特許第4772516号明細書に記載されており、これは生成物のポリマーを塩素を除去するのに十分な時間アンモニアで処理することを含むものである。

【0015】上記の後者の方のシラザンポリマーは、トリクロロシランとジシラザンとを、揮発性副生物を蒸留しながら25~300℃の範囲の温度で本質的に無水の不活性雰囲気中で接触及び反応させることを含む方法により調製される。この方法で用いられるジシラザンは式(R<sub>8</sub>Si)₂MIを有し、この式のRはピニル基、水素原子、フェニル基及び炭素原子数1~3のアルキル基から選ばれる。この後者のポリマーの殊に好ましい態様は、トリクロロシランとヘキサメチルジシラザンを反応させてヒドリドポリシラザンを生成することを必要とする。

【0016】ここではいく種類かのポリマーのみを説明 しているだけであるが、本発明においてはほとんどどの ようなポリシラザンを使用してもよい。

【0017】ここで使用される充填剤は、他のポリマー とともに被覆(コーティング)において使用するために 当該技術分野で知られているものである。これらには、 粉体、粒体、フィラメント、フレーク及び微小中空球を 含めたいろいろな形態の、様々な無機及び有機の充填 剤、殊に無機充填剤、が含まれる。無機充填剤の例に は、合成及び天然の材料、例えば種々の金属及び非金属 の酸化物、窒化物、ホウ化物及び炭化物の如きもの、例 を挙げればガラス、アルミナ、シリカ、一酸化ケイ素、 酸化ジルコニウム、二酸化チタン、酸化タンタル、酸化 ニオブ、酸化亜鉛、酸化タングステン、酸化ルテニウ ム、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、二ホウ化チタン、 炭化ケイ素、炭化ホウ素、窒化ホウ素といったようなも のや、炭酸カルシウムや、高誘電率充填剤、例えばスト ロンチウム、ジルコニウム、パリウム、鉛、ランタン、 鉄、亜鉛及びマグネシウムのような金属のチタン酸塩、 ニオブ酸塩又はタングステン酸塩(これらには、チタン 酸パリウム、チタン酸カリウム、ニオブ酸鉛、チタン酸 リチウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸ストロン チウムバリウム、チタン酸ジルコニウムランタン鉛、チ タン酸ジルコニウム鉛及びタングステン酸鉛が含まれ る) の如きものや、放射線不透過性の材料(放射線の透 過を防止する材料)、例えばパリウム、鉛、銀、金、カ ドミウム、アンチモン、スズ、パラジウム、ストロンチ ウム、タングステン及びピスマスの不溶性塩類のような もの(これらには炭酸塩、硫酸塩及び酸化物といったよ うな塩類(例、硫酸バリウム)が含まれる)や、光学的 に不透明な充填剤、例えば無機顔料、窒化ケイ素粉末、

ルミナのようなものや、いたずら防止 (tamperproof)材 料(酸化により熱を発する材料)、例えばマグネシウ ム、鉄、スズ、ケイ素、亜鉛のようなものや、沈降ケイ ソウ土、ケイ酸アルミニウム又は他のケイ酸塩類、顔 料、蛍光体、珪灰石、雲母、カオリン、粘土及びタルク が含まれる。同様に、何らかの有機材料、例えばセルロ ース、ポリアミド及びフェノール樹脂等を使用してもよ ٧٤٠)

【0018】本発明で使用される好ましい充填剤は、被 覆に対して意図される用途に依存する。 例を挙げれば、 被覆を層間誘電体として使用する場合には、被覆の誘電 率が8未満の低いものになるように、シリカあるいはア ルミナのような材料が望ましかろう。同じように、12 より高い誘電率を持つ被覆が所望される場合には、チタ ン酸バリウムあるいはニオブ酸鉛のような材料が望まし かろう。同様に、不透明な被覆が所望される場合には、 光学的に不透明なあるいは放射線不透過性の材料が望ま しかろう。

【0019】上記の充填剤の数平均粒子寸法と形状は、 充填剤の種類、所望の被覆厚さその他のような因子に応 20 じて広い範囲にわたって変えることができる。被覆は一 般には厚さが 5 0 0 μm未満であるから、これより小さ い粒子寸法が一般には使用される。好ましい数平均粒子 寸法は50μm未満の範囲にあり、最も好ましい数平均 粒子寸法は $10\mu$ mまでのサブミクロン範囲にある。

[0020] 本発明で使用される充填剤の量も、例えば 最終の被覆に求められる品質や電気的特性に応じて、広 い範囲にわたって変えることができる。一般には、充填 剤は、充填剤を結合するのに十分な樹脂が存在するのを 保証するようにポリシラザンの重量を基にして90重量 30 %未満の量で用いられる。明らかに、より少量(例えば 1~5重量%)の充填剤を使用することもできる。

【0021】所望ならば、本発明の被覆組成物中にはこ のほかの物質が存在してもよい。例えば、充填剤の表面 をより良好な接着性のために改質する物質を使用しても よい。そのような物質には、例えば、グリシドキシプロ ピルトリメトキシシラン、メルカプトプロピルトリメト キシシラン及びピニルトリアセトキシシランのようなシ ラン類を含めることができる。同様に、沈殿防止剤、例 としてセルロース、粘土、ヒュームドシリカ、ステアレ 40 ート類その他の如きものを、被覆組成物に含ませること ができる。これら及びこのほかの任意的な成分は当業者 に知られているものである。

【0022】本発明の方法によれば、ポリシラザン、充 填剤及び何らかの任意的成分を、基材の表面に適用す る。これは、いずれのやり方で行うこともできるが、好 ましい方法はポリシラザンを溶媒に溶解させ、次いで充 填剤を何らかの任意的成分とともにそれに分散させるこ とを必要とする。続いて、この分散液を基材の表面に塗 布する。ポリシラザン又は充填剤を溶解又は分散させる 50 くはマイクロ波エネルギーを利用すること等が、本発明

のに、そしてより均一な塗布材料を作るのに、いろいろ な促進手段、例えば攪拌及び/又は加熱の如きものを、 利用することができる。溶媒は、ポリシラザン及び充填 剤を溶解又は分散させて、結果として得られる被覆に影 響を及ぼさない液体混合物を作る任意の薬剤又は複数の 薬剤の混合物でよい。これらの溶媒には、上述の材料を 塗布のために求められる濃度に溶解/分散させるのに十 分な量の、ベンゼン又はトルエンのような芳香族炭化水 素、n-ヘプタン又はドデカンのようなアルカン、ケト 10 ン、エステル、グリコールエーテル、あるいは環状ジメ チルポリシロキサンを含めることができる。一般には、 0. 1~80重量%混合物、好ましくは1~50重量% 混合物を作るのに十分な上記の溶媒が使用される。

【0023】液体法を使用する場合には、ポリシラザ ン、充填剤、溶媒と、そしていずれかの任意的な成分を 含んでなる液体混合物を、基材へ塗布する。この塗布の 方法は、回転塗布、浸漬塗布、吹付け塗布又は流し塗り によるものでよい。同様に、被覆はマスキング法あるい はシルクスクリーン法により選択的に付着させてもよ い。とは言え、このほかの同等の手段も可能である。

【0024】溶媒は、塗布した基材から後に蒸発させ て、その結果ポリシラザンと充填剤の被覆を付着させ る。周囲環境への暴露による単純な空気乾燥のような、 あるいは真空もしくは穏やかな加熱(例えば50℃未 満) の適用によるような、あるいは熱処理のうちの初期 の段階によるような、任意の適当な蒸発の手段を使用す ることができる。回転塗布を利用する場合には、回転工 程で溶媒が除去されるので、追加の乾燥時間が最小限に なる。

【0025】上記の方法は液体アプローチを使用するこ とに主として焦点を合わせてはいるが、当業者はここで はこのほかの同等の手段もまた機能を果たすであろうこ とを認めよう。

【0026】次いで、ポリシラザンと充填剤の被覆を、 典型的にはそれを十分な温度に加熱して、セラミックに 変える。一般には、この温度は、熱分解の雰囲気に応じ て50~1000℃の範囲内である。好ましい温度は1 00~800℃の範囲であり、より好ましくは150~ 500℃の範囲である。加熱は、一般にはセラミック化 するのに十分な時間、典型的には最高で6時間、行わ れ、3時間未満がより好ましい。

【0027】上記の加熱は、真空から加圧(超大気圧) までの任意の有効な雰囲気圧力で、且つ、任意の有効な 酸化性又は非酸化性の気体環境下で、例えば、空気、 02、酸素プラズマ、不活性ガス、窒素、アンモニア、ア ミン類、温分及び№0 を含むもの等の環境下で、行うこ とができる。

【0028】任意の加熱の方法、例を挙げれば対流オー プン、迅速熱処理、ホットプレート、あるいは輻射もし

において一般的に有効である。更に、加熱の速度も重要 ではないが、可能な限り迅速に加熱することが最も実用 的であり、且つ好ましい。

【0029】上述の方法によって、基材上にセラミック 被覆が作られる。被覆の厚さは、広い範囲にわたって変 えることができる(最高500μmまで)。これらの被 覆は、いろいろな基材の不ぞろいな表面をならし、比較 的欠陥がなく、接着特性が優れており、且つ様々な電気 的特性(例えば低い誘電率あるいは高い誘電率)を有す ーション、誘電性又はいたすら防止層)のようないろい ろな電子工学用途に対して特に有用である。

【0030】所望ならば、これらの被覆の上に更に別の 被覆を適用してもよい。これらには、SiO2、SiO2/セラ ミック酸化物、ケイ素、ケイ素ー炭素、ケイ素ー窒素、 ケイ素ー窒素ー酸素、ケイ素ー窒素ー炭素の被覆及び/ 又はダイヤモンド様の炭素被覆を含めることができる。 そのような被覆を適用するための方法は当該技術分野で 知られており、これらの多くは米国特許第475697 ラシクロプタンの化学気相成長によって適用される炭化 ケイ素である。この具体的な方法は、米国特許第501 1706号明細書に記載されている。

[0031]

【実施例】当業者が本発明をより容易に理解することが できるように、以下の非限定の例を提供する。

【0032】例1

数平均粒子寸法が5μmのシリカガラス微小中空球 (S DT-60) の0. 3gを乳鉢と乳棒で数分間粉砕し て、粒子寸法を小さくした。次に、この粉砕したガラ ス、米国特許第4540803号明細書の方法で作った 2gのヒドリドポリシラザン(キシレン中で50重量% 固形分)、0.2gのMinusil(商標)、及び 0. 4gのグリシドキシプロピルトリメトキシシランを 混合して、被覆組成物を作った。音波プロープを20秒 間使ってこれらの材料を完全に分散させた。この被覆組 る。このように、それらは例えば保護層(例、パッシベ 10 成物を、 $50 \mu$ mのドローダウンパーを使用して11. 4 cm2 のアルミニウムパネルの表面に塗布した。この被 覆を1. 5時間乾燥させた。次いで、被覆したパネルを 500℃で1時間加熱した。この被覆は、厚さが12. 5μmであり、1000倍で調べて割れがなかった。

【0033】例2

数平均粒子寸法が6μmのプラズマアルミナ4g、米国 特許第4540803号明細書の方法で作った2gのヒ ドリドポリシラザン(キシレン中で50重量%固形 分)、0.4gのグリシドキシプロピルトリメトキシシ 7号明細書に記載されている。殊に好ましい被覆は、シ 20 ラン、及び1gの環状ポリジメチルシロキサンを混合し た。音波プロープを30秒間使ってこれらの材料を完全 に分散させた。この被覆組成物を、50μmのドローダ ウンパーを使って11. 4 cm<sup>2</sup> のアルミニウムパネルの 表面に塗布した。この被覆を5分間乾燥させた。次い で、被覆したパネルを500℃で1時間加熱した。この 被覆は、厚さが $16.1\mu$ mであり、1000倍で調べ て割れがなかった。